

BERICHTIGTE FASSUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. August 2004 (12.08.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/068608 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 51/20**

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CN, JP, KR, US.

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/004036

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(22) Internationales Anmeldedatum:
8. Dezember 2003 (08.12.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 01 086.6 14. Januar 2003 (14.01.2003) DE

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 14. Oktober 2004

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): POLYIC GMBH & CO. KG [DE/DE];
Paul-Gossen-Strasse 100, 91052 Erlangen (DE).

(48) Datum der Veröffentlichung dieser berichtigten
Fassung: 4. August 2005

(72) Erfinder; und

(15) Informationen zur Berichtigung:
siehe PCT Gazette Nr. 31/2005 vom 4. August 2005, Sec-
tion II

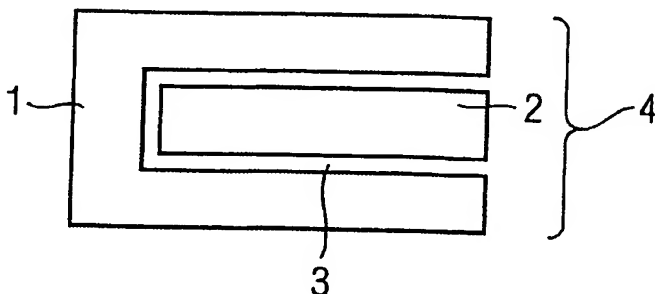
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIX, Walter [DE/DE];
Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ULLMANN, An-
dreas [DE/DE]; Kronstädter Str. 16a, 90765 Fürth (DE).

(74) Anwalt: ZINSINGER, Norbert; Patentanwälte Louis,
Pöhlau, Lohrentz, P.O. Box 30 55, 90014 Nürnberg (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC FIELD EFFECT TRANSISTOR AND INTEGRATED CIRCUIT

(54) Bezeichnung: ORGANISCHER FELDEFFEKT TRANSISTOR, INTEGRIERTER SCHALTKREIS



(57) Abstract: The invention relates to an organic field effect transistor (OFET) and/or an organic-based integrated circuit with a high operating frequency. Compact, high-speed circuit layouts are obtained by positioning the two ends of the current channel in close proximity.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen organischen Feldeffekt Transistor (OFET) und/oder einen integrierten Schaltkreis auf organischer Basis mit hoher Schaltfrequenz. Durch die Zusammenlegung der beiden Enden des Stromkanals ergeben sich kompakte und schnelle Schaltungs-Layouts.